

## **The Data Book Project**

DatasheetArchive.com has launched an ambitious effort to digitize thousands of obsolete data books and technical manuals, making them searchable via the DatasheetArchive website.

**Scroll down to see the scanned document.**

## Diffundierter Silizium-NPN-Mesa-Leistungstransistor *Diffused Silicon NPN Mesa Power Transistor*

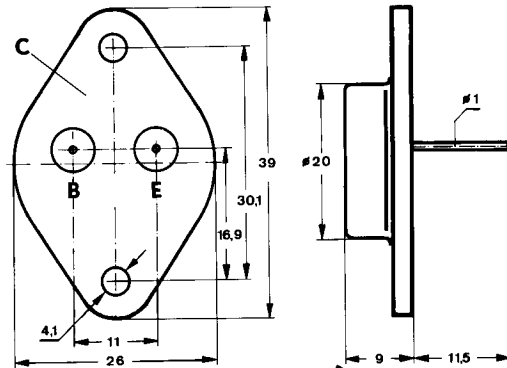
**Anwendung:** Horizontal-Ablenk-Endstufen in Schwarz-Weiß-Fernsehgeräten  
**Application:** *Horizontal deflection circuits in black and white TV-receivers*

**Besondere Merkmale:**

- In Dreifachdiffusions-Mesa-Technik
- Hohe Sperrspannung
- Kurze Schaltzeit
- Verlustleistung 32 W

**Features:**

- *In triple diffusion mesa technique*
- *High reverse voltage*
- *Short switching time*
- *Power dissipation 32 W*

**Abmessungen in mm  
*Dimensions in mm***


Kollektor mit  
Gehäuse verbunden  
*Collector connected  
with case*

**Zubehör  
*Accessories***

Isolierscheiben Best. Nr. 515390  
*Isolating washers* Best. Nr. 562897

Normgehäuse  
Case  
3 B 2 DIN 41872  
JEDEC TO 3  
Gewicht · *Weight*  
max. 20 g

# BU 226

## Absolute Grenzwerte

### Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung <i>Collector-base voltage</i>	$U_{CBOM}^{1)}$	2000	V
Kollektor-Emitter-Spannung <i>Collector-emitter voltage</i>	$U_{CEO}$	800	V
Kollektor-Emitter-Spannung <i>Collector-emitter voltage</i> $R_{BE} \leq 100 \Omega$	$U_{CERM}$	2000	V
Kollektorspitzenstrom <i>Collector peak current</i>	$I_{CM}^{2)}$	2	A
Kollektorstrom, Mittelwert <i>Collector current, average</i>	$I_{CAV}$	1,5	A
Basisstrom <i>Base current</i>	$I_{BM}$ $-I_{BM}$	1,5 1,2	A A
Gesamtverlustleistung <i>Total power dissipation</i> $t_{case} \leq 25^\circ C$	$P_{tot}$	32	W
Sperrschichttemperatur <i>Junction temperature</i>	$t_j$	105	$^\circ C$
Lagerungstemperaturbereich <i>Storage temperature range</i>	$t_{stg}$	-65 ... +105	$^\circ C$

### Wärmewiderstand *Thermal resistance*

Min. Typ. Max.

Sperrschicht-Gehäuse <i>Junction case</i>	$R_{thJC}$		2,5	$^\circ C/W$
--	------------	--	-----	--------------

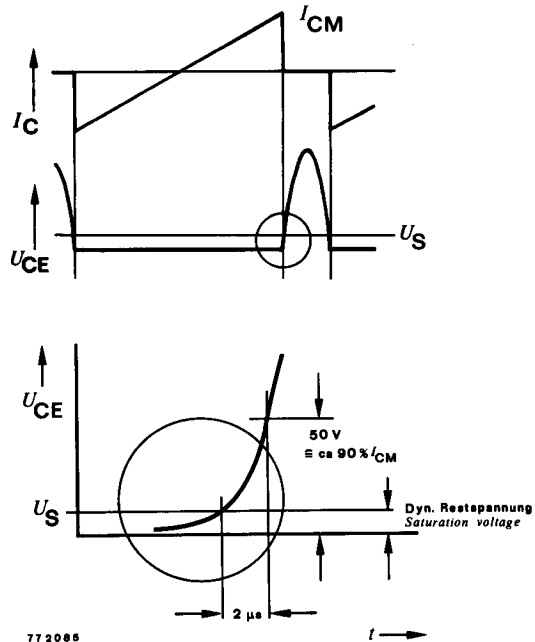
### Kenngößen *Characteristics*

$t_{amb} = 25^\circ C$				
Kollektorreststrom <i>Collector cut-off current</i> $U_{CE} = 2000 V$	$I_{CES}$		1	mA
Emitter-Basis-Durchbruchspannung <i>Emitter-base breakdown voltage</i> $I_E = 100 mA$	$U_{(BR)EBO}$	5		V
Dynamische Restspannung <i>Collector-emitter saturation voltage</i> $I_C = 1 A; I_B = 0,4 A$	$U_{Rest dyn}$		10	V
Abfallzeit <i>Fall time</i> $I_C = 1 A, I_B = 0,4 A$	$t_f$	0,7		$\mu s$

Fig. 1

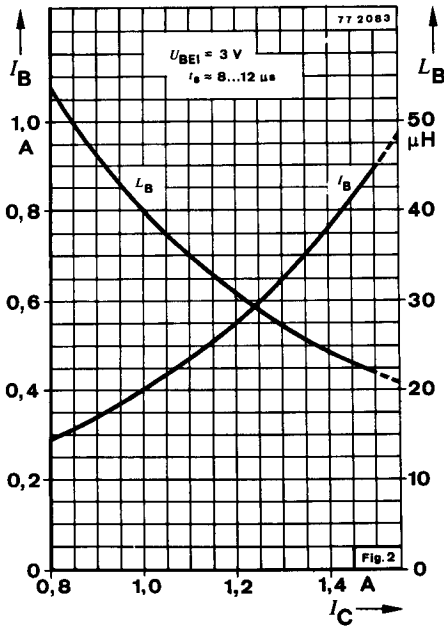
<sup>1)</sup> Stoßspitzenspannung bei Bildröhrenüberschlägen 2200 V  
*Flash over voltage, non repetitive 2200 V*

<sup>2)</sup> Stoßspitzenstrom bei Bildröhrenüberschlägen  $\leq 3 A$   
*Flash over current, non repetitive  $\leq 3 A$*



**Fig. 1** Definition von  $U_{Rest\ dyn}$   
Definition from  $U_{Rest\ dyn}$

77 2085



Ansteuerungsdiagramm bezieht sich auf:

$I_B = \text{konstant}$  für die Zeit  $t_H - t_S$

Optimaler Betriebsbereich bei:

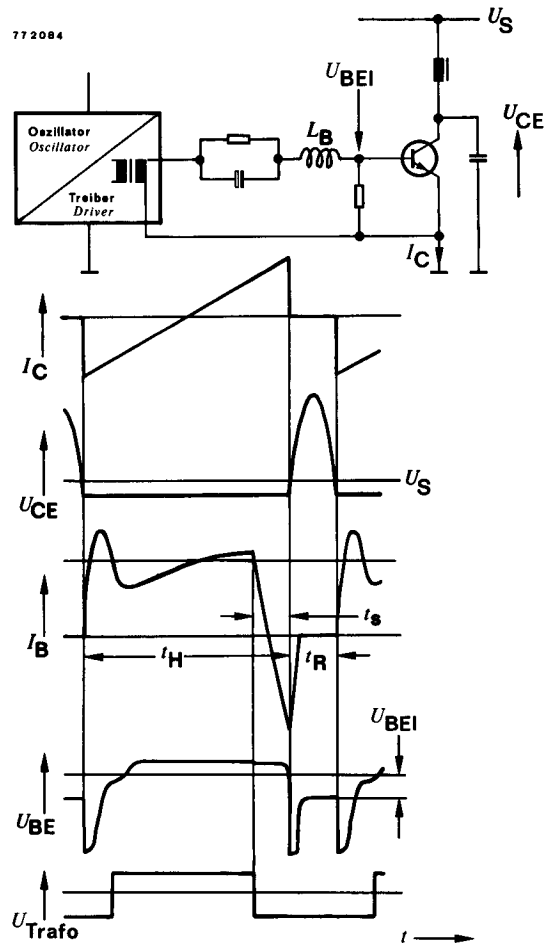
$I_C = 1 \dots 1,2\text{ A}$

Control diagram is specified for:

$I_B = \text{constant}$  for the time  $t_H - t_S$

Optimum operating range

$I_C = 1 \dots 1,2\text{ A}$



**Fig. 3** Funktionsschaltung zur Messung des Schaltverhaltens und deren Impulsverlauf  
 Test circuit for switching characteristics and its pulse diagram